

# UNR5225/5226/5227

## Silicon NPN epitaxial planer transistor

For muting

### ■ Features

- Low collector to emitter saturation voltage  $V_{CE(sat)}$ , optimum for the muting circuit.  $V_{CE(sat)}$ : 30 mV (typ.)
- The use with high current value is possible.  $I_C$ : 600 mA

### ■ Resistance by Part Number

	Marking symbol	(R <sub>1</sub> )	(R <sub>2</sub> )
• UNR5225	FZ	10 kΩ	—
• UNR5226	FY	4.7 kΩ	—
• UNR5227	FW	6.8 kΩ	6.8 kΩ

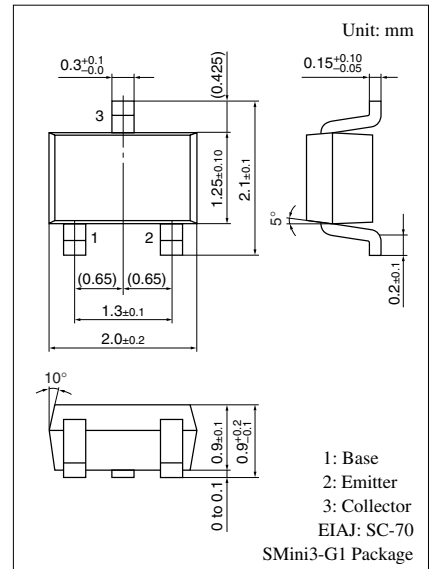
### ■ Absolute Maximum Ratings T<sub>a</sub> = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to base voltage	V <sub>CBO</sub>	30	V
Collector to emitter voltage	V <sub>CEO</sub>	20	V
Emitter to base voltage	V <sub>EBO</sub>	5	V
Collector current	I <sub>C</sub>	600	mA
Total power dissipation	P <sub>T</sub>	150	mW
Junction temperature	T <sub>j</sub>	150	°C
Storage temperature	T <sub>stg</sub>	-55 to +150	°C

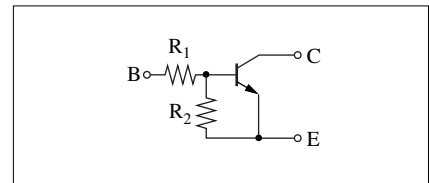
### ■ Electrical Characteristics T<sub>a</sub> = 25°C ± 3°C

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Collector cutoff current	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = 30 V, I <sub>E</sub> = 0			1	μA
Emitter cutoff current	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = 5 V, I <sub>C</sub> = 0			1	μA
Collector to base voltage	V <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> = 1 μA, I <sub>E</sub> = 0	30			V
Collector to emitter voltage	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = 1 mA, I <sub>B</sub> = 0	20			V
Emitter to base voltage	V <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> = 1 μA, I <sub>C</sub> = 0	5			V
Forward current transfer ratio	UNR5227	h <sub>FE</sub> V <sub>CE</sub> = 5 V, I <sub>C</sub> = 50 mA	70			
	UNR5225/5226		100		600	
Collector to emitter saturation voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 50 mA, I <sub>B</sub> = 2.5 mA			80	mV
Input resistance	UNR5226	R <sub>1</sub>	-30%	4.7	+30%	kΩ
	UNR5227			6.8		
	UNR5225			10		
Resistance ratio	UNR5227	R <sub>1</sub> /R <sub>2</sub>	0.8	1.0	1.2	
ON-resistance *	UNR5226	R <sub>ON</sub>	V <sub>I</sub> = 7 V, R <sub>L</sub> = 1 kΩ, f = 1 kHz	0.95		Ω
	UNR5227			1.1		
	UNR5225			1.5		
Transition frequency	f <sub>T</sub>	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = -50 mA, f = 200 MHz		200		MHz

Note) \*: Refer to R<sub>ON</sub> measurement circuit

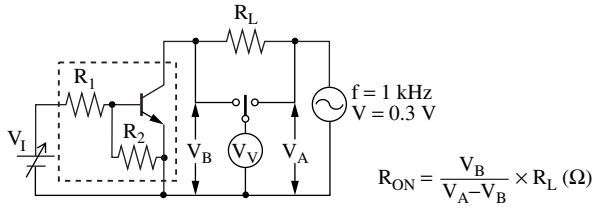


### Internal Connection

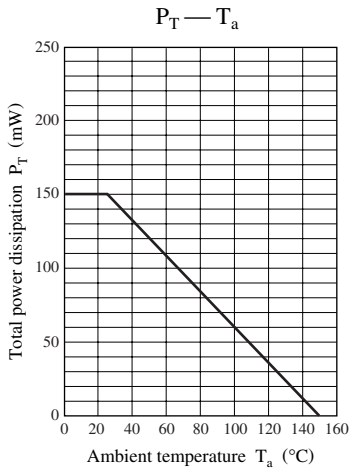


■ Electrical Characteristics (continued)  $T_a = 25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$

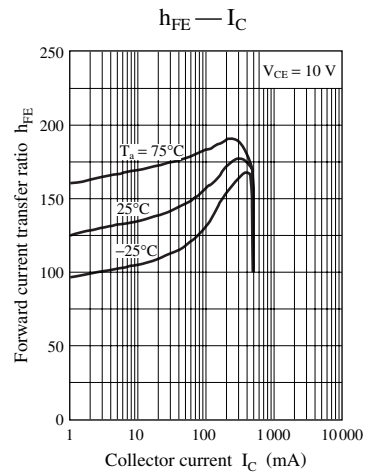
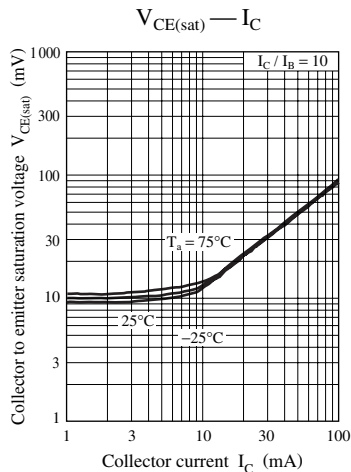
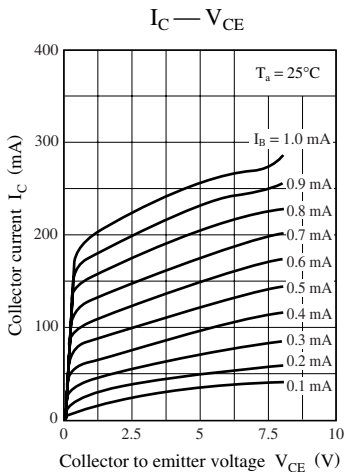
- $R_{ON}$  measurement circuit

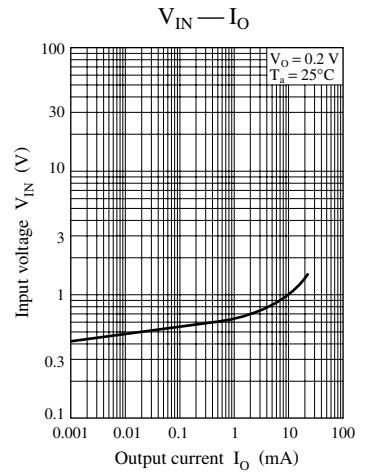
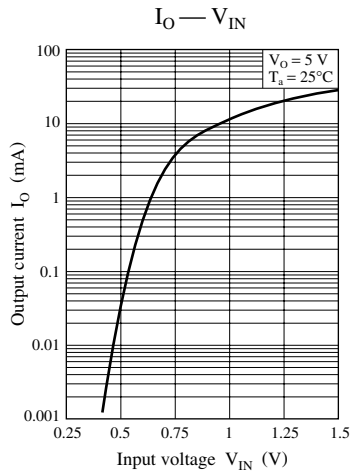
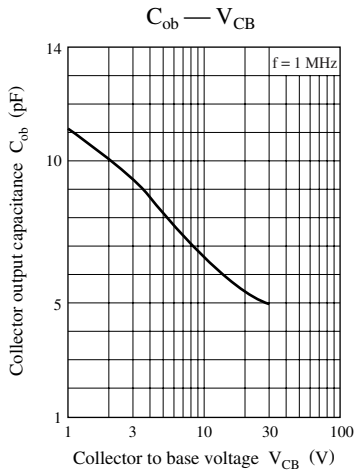


Common characteristics chart

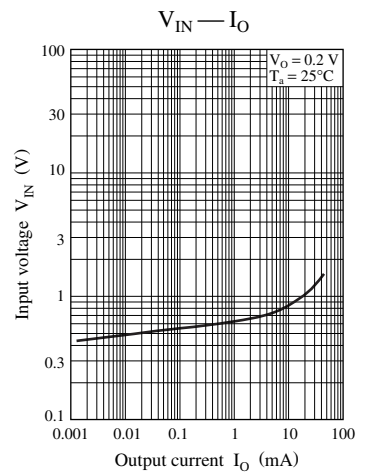
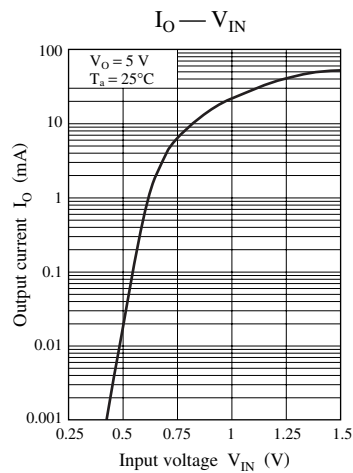
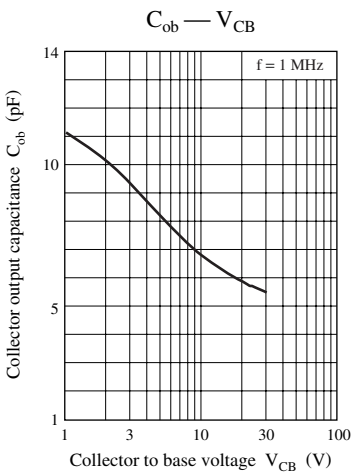
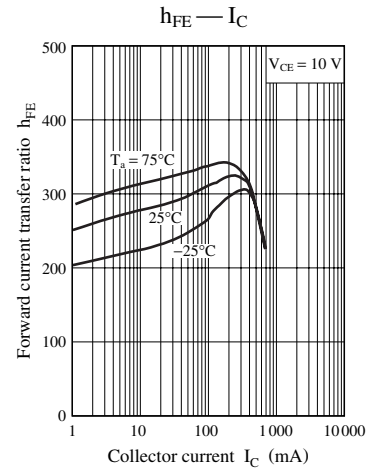
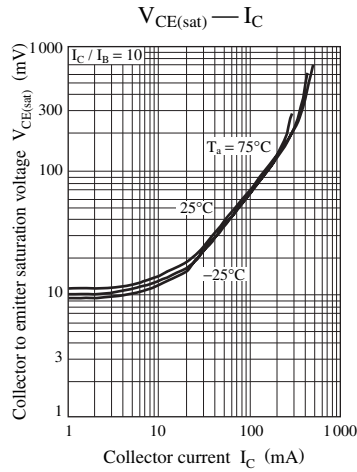
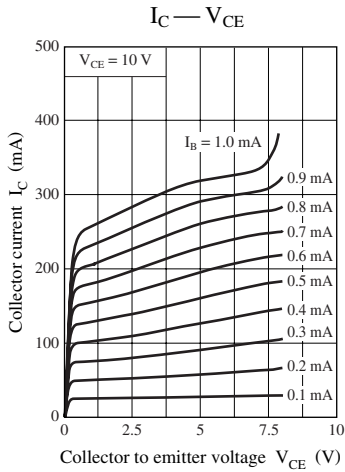


Characteristics charts of UNR5225

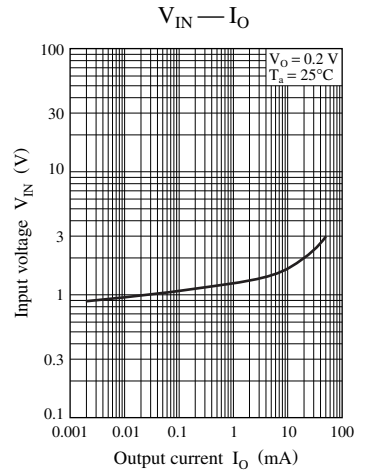
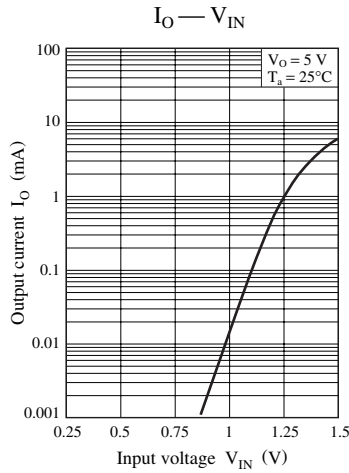
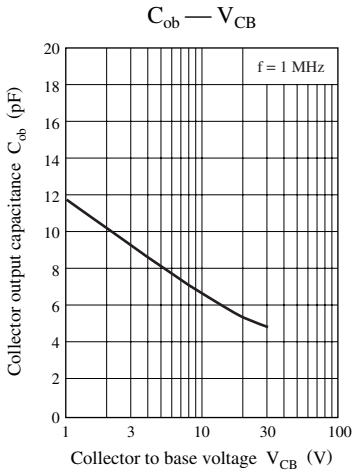
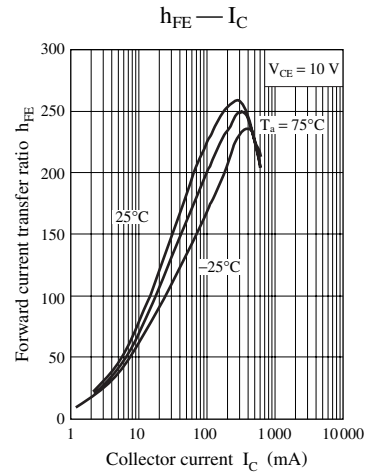
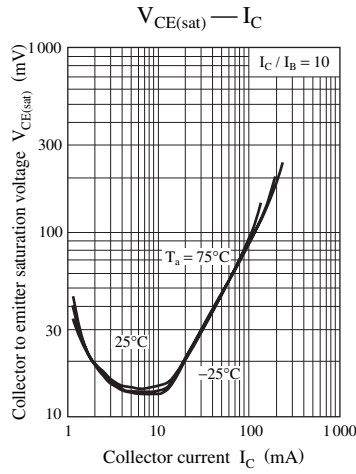
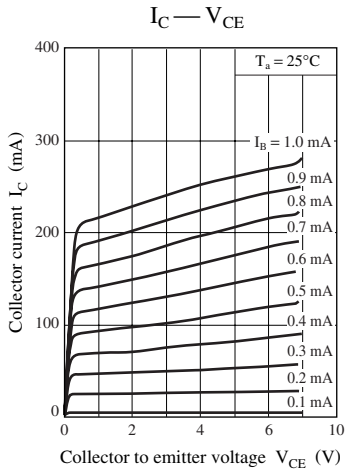




Characteristics charts of UNR5226



Characteristics charts of UNR5227



## 本資料に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本資料に記載の製品および技術で、「外国為替及び外国貿易法」に該当するものを輸出する時、または、国外に持ち出す時は、日本政府の許可が必要です。
- (2) 本資料に記載の技術情報は製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、工業所有権等の保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- (3) 本資料に記載されている製品は、標準用途 — 一般電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)に使用されることを意図しております。

特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(航空・宇宙用、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置など)にご使用をお考えのお客様および当社が意図した標準用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。

- (4) 本資料に記載しております製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際して、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性については保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。保証値を超えてご使用された場合、その後に発生した機器の欠陥については弊社として責任を負いません。  
また、保証値内のご使用であっても、弊社製品の動作が原因でご使用機器が各種法令に抵触しないような冗長設計をお願いします。
- (6) 防湿包装を必要とする製品につきましては、個々の仕様書取り交わしの折、取り決めた条件(保存期間、開封後の放置時間など)を守ってご使用ください。
- (7) 本資料の一部または全部を弊社の文書による承諾なしに、転載または複製することを堅くお断りいたします。

## 本資料(データシート)ご利用に際しての注意事項

- A. 本資料は、お客様のご用途に応じた適切な松下半導体製品を購入いただくためのご紹介資料です。記載されている販売可能な品種および技術情報等は、予告なく常に更新しておりますので、ご検討にあたっては、早めに弊社営業部門にお問い合わせの上、最新の情報を入手願います。
- B. 本資料は正確を期し、慎重に制作したのですが、記載ミス等の可能性があります。したがって、弊社は資料中の記述誤り等から生じる損害には責任を負わないものとさせていただきます。
- C. 本資料は、お客様ご自身でのご利用を意図しております。したがって、弊社の文書による許可なく、インターネットや他のあらゆる手段によって複製、販売および第三者に提供するなどの行為を禁止いたします。